

(54) MAGNETIC MATERIAL CONTAINING IRON NITRIDE AND ITS PREPARATION

(11) 59-45911 (A) (43) 15.3.1984 (19) JP
(21) Appl. No. 57-35895 (22) 9.3.1982
(71) NIPPON KOGYO K.K. (72) HIROYASU FUJIMORI(3)
(51) Int. Cl.³. C01B21/06, C23C15/00//H01F1/10, H01F1/34

PURPOSE: To prepare the titled high-performance magnetic material, rapidly, by the reactive sputtering in an atmosphere of N_2 and Ar gas using pure iron as a target under specific condition.

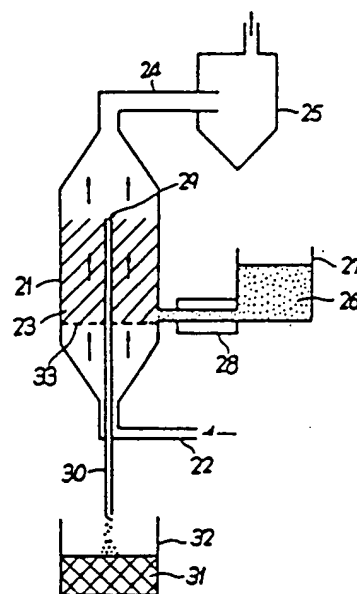
CONSTITUTION: Pure iron used as a target for the reactive sputtering is cooled with water to attain a substrate temperature of $\leq 300^\circ\text{C}$. A magnetic material containing $\geq 10\text{wt}\%$ of $Fe_{16}N_2$ and having a thickness of $\geq 1\mu\text{m}$ can be obtained by the reactive sputtering in an atmosphere of N_2 and Ar having an N_2 -partial pressure of 1×10^{-2} Torr. A magnetic material having excellent saturation magnetic properties can be prepared from pure iron by this process.

(54) CONTINUOUS PREPARATION OF SIALON SUBSTANCE

(11) 59-45912 (A) (43) 15.3.1984 (19) JP
(21) Appl. No. 57-151741 (22) 2.9.1982
(71) KAWASAKI SEITETSU K.K.(2) (72) EIZOU MAEDA(2)
(51) Int. Cl.³. C01B21/068//B01J8/23

PURPOSE: To prepare sialon substance in a mass at a low cost, by charging a mixture of carbon and silica or silica-alumina compound continuously from the top of the reactor, and fluidizing and reacting with the N_2 -containing gas stream supplied from the bottom of the reactor.

CONSTITUTION: Powdery or granular mixture 26 of carbon and silica or a silica-alumina compound is supplied from the container 27 through the feeder 28 to the top reaction chamber of a fluidizing apparatus 21, and is fluidized with the N_2 -containing gas supplied from the inlet 22 attached at the bottom of the reactor. The fluidized mixture is made to react with the N_2 -containing gas, and the produced silicon nitride or the sialon substance is discharged continuously through the outlet 30 to the container 32. The exhaust gas of the reaction is discharged through the gas outlet 24 and the dust collector 25 from the system.



(54) PURIFICATION OF PHOSPHINE

(11) 59-45913 (A) (43) 15.3.1984 (19) JP
(21) Appl. No. 57-154003 (22) 6.9.1982
(71) NIPPON KAGAKU KOGYO K.K. (72) SHIYUUKICHI NABEKAWA(4)
(51) Int. Cl.³. C01B25/06

PURPOSE: To adsorb and remove hydrogenated arsenic compound, selectively and efficiently from crude phosphine containing the compound as an impurity, by contacting the crude phosphine with active carbon in the absence of oxygen.

CONSTITUTION: A reaction vessel filled with active carbon is made oxygen-free state by introducing an inert gas into the vessel or evacuating the vessel. A crude phosphine containing 50~300ppm of hydrogenated arsenic compound (e.g. arsine) as an impurity is introduced into the reaction vessel, and made to contact with the active carbon under the pressure of 0~60kg/cm² to adsorb the hydrogenated arsenic compound to the active carbon and remove the compound from the system. The weight ratio of the phosphine to the active carbon is ≤ 1 . The used active carbon can be regenerated by evacuating at 100~130°C.

12 公開特許公報 (A)

昭59—45911

⑤ Int. Cl.³
C 01 B 21/06
C 23 C 15/00
// H 01 F 1/10
1/34

識別記号

庁内整理番号
7508—4G
7537—4K
7354—5E
7354—5E

43 公開 昭和59年(1984)3月15日

発明の数 2
審査請求 未請求

(全 4 頁)

④ 窒化鉄含有磁性材料およびその製造方法

① 特 願 昭57—35895

② 出 願 昭57(1982)3月9日

特許法第30条第1項適用 昭和56年10月20日
発行社団法人日本応用磁気学会の第5回日本
応用磁気学会学術講演概要集において発表

⑦ 発 明 者 藤森啓安

宮城県宮城郡宮城町2丁目20の
3

⑦ 発 明 者 狩野彰

仙台市越路6の8こえじ荘15

⑦ 発 明 者 風間典昭

仙台市国見一丁目12の8

⑦ 発 明 者 高橋賢

仙台市八木山弥生町20の11

⑧ 出 願 人 日本鉱業株式会社

東京都港区虎ノ門二丁目10番1
号

⑧ 代 理 人 弁理士 並川啓志

明 細 書

第3項記載の方法。

3 発明の詳細な説明

1. 発明の名称

窒化鉄含有磁性材料およびその製造方法

2. 特許請求の範囲

- (1) 純鉄をターゲットとし、窒素含有雰囲気中の反応性スパッタリングにより形成した磁性材料において、該磁性材料は1 μm 以上の厚さを有し、かつ該磁性材料の中に10重量%以上の Fe_xN_y を含有することを特徴とする窒化鉄含有磁性材料。
- (2) 基板温度を300℃以下とし、窒素分圧 (P_{N_2}) 1×10^{-1} Torr以下の窒素とアルゴンガス雰囲気中で反応性スパッタリングを行うことにより Fe_xN_y を多量に含有する磁性材料を製造する方法。
- (3) 基板温度を200℃以下とする特許請求の範囲第2項記載の方法。
- (4) 窒素分圧 (P_{N_2}) を $2 \sim 7 \times 10^{-1}$ Torrとしたことを特徴とする特許請求の範囲第2項および

この出願の発明は、 Fe_xN_y を多量に含有する磁性材料およびスパッタリングによる該磁性材料の製造方法に関する。

磁性材料の分野で純鉄は最も基本的な材料で、比較的高い透磁率を示し、かつ高い飽和磁化 ($\sigma_s = 218 \text{ emu/gr}$, $M_s = 1717 \text{ gauss}$) を有しているため、起電器および電磁石の磁心や接触子または磁気回路の磁鉄などに利用されているが、鉄の窒化物である Fe_xN_y は第1表に示すように、上記の純鉄よりもさらに高い飽和磁化 (単位重量当りの飽和磁化 $\sigma_s = 298 \text{ emu/gr}$, 単位体積当りの飽和磁化 $M_s = 2200 \text{ gauss}$) を持つている。Tcはキュリー点を示す。ところが同じ窒化物でも Fe_3N は純鉄の中で不純物として存在し、第1表に示すように磁性を著しく劣化させるものであつた。

		σ_0	M_0	T_c
α	Fe bcc	218	1717	1041.8
α'	Fe ₁₁ N ₄ bcc	298	2200	(573)
δ'	Fe ₄ N fcc	201	1583	761
ϵ	Fe ₃ N hcp			
ζ	Fe ₃ N oth			

窒化鉄の製造の中で、Fe₃Nの発生を抑制し、Fe₁₁N₄を多量に生成させる有効な技術は、従来存在せず、わずかにN₂雰囲気中で真空蒸着によつてFe₁₁N₄を製造する試みがなされた程度である。

しかしこの真空蒸着にしてもN₂との反応がわずかでかつ蒸着速度も極めておそく、しかも500A°程度の極薄のものしかできないので工業的に利用するには到底及ばないものであつた。

本発明は、この点に鑑みてなされたもので、純鉄をターゲットとし、窒素含有雰囲気中での反応性スパッタリングにより形成した磁性材料

生が多くなり、Fe₁₁N₄の発生はなくなる。本発明は多くの試みの中で、この点に着目したものであるが、このような窒化物の製造において、窒素分圧 P_{N_2} を下げ、より低圧側にすることは常識では考えられないことである。

P_{N_2} のさらに有効な範囲は $2 \sim 7 \times 10^{-4}$ Torrであり、 2×10^{-4} Torrよりも低いと、純鉄よりも飽和磁化が低下していく。

さらにまた後述するようにFe₁₁N₄は加熱により分解する。

特に250～300℃を超える温度では磁気特性に劣るFe₃Nに変化していく。

スパッタリング操作中では、フィラメントからの放射熱によつて加熱され、また基板温度も上昇するので、前記Fe₁₁N₄からFe₃Nへの変化はスパッタリング操作中においても生じる。

したがつてこれを抑制するために基板温度は300℃以下にする必要がある。この基板温度のより有効な範囲は200℃以下である。

以上のように窒素ガス分圧 P_{N_2} の調節と基板

において、該磁性材料は1 μm 以上の厚さを有し、かつ該磁性材料の中に10重量%以上のFe₁₁N₄を含有することを特徴とする窒化鉄含有磁性材料および基板温度を300℃以下とし、窒素分圧(P_{N_2}) 1×10^{-4} Torr以下の窒素とアルゴンガス雰囲気中で反応性スパッタリングを行うことによりFe₁₁N₄を多量に含有する磁性材料を製造する方法に関する。

これにより磁性特性に優れた磁性材料が得られ、また製造速度も著しく速くなつたので、安価で高性能の磁性材の製造が可能になつた。反応性スパッタリングにより窒化物を製造する場合には、アルゴンガスの他に窒素ガスを導入し、アルゴンと窒素の混合ガス雰囲気とする必要があるが、窒素ガスは少量で、分圧(P_{N_2}) 1×10^{-4} Torr以下としなければならない。

一般に窒素分圧 P_{N_2} が高いとそれだけ窒化物の生成速度が速くなり、したがつてFe₁₁N₄が多量に製造できると考えがちであるが、窒素分圧(P_{N_2})が 1×10^{-4} Torrを越ええるとFe₃Nなどの発

生速度の臨界的条件の選定により、初めてFe₁₁N₄を多量に含有する窒化鉄の製造が可能となつた。後段の実施例で説明するように水冷銅板上のガラス基板にスパッタリングした場合に、約3 μm のFe₁₁N₄含有磁性材料が生成するが、冷却速度を高めることにより、さらに厚い磁性材料を形成することができ、またスパッタリング速度も高めることができる。このような形状を有する磁性材料は工業的に利用できる。

さらにまた純鉄の飽和磁化を超える良好な性質を得るためには、Fe₁₁N₄を少なくとも10重量%以上がスパッタリングされた磁性材料中に存在することが必要である。Fe₁₁N₄以外の磁性材料成分は純鉄が主であるが、他の窒化物すなわちFe₃N等が磁気特性を劣化しない程度に含有されることは止むを得ない。

本発明の上記条件で実施することにより、Fe₁₁N₄を多量に含有する磁性材料は、純鉄を超える飽和磁化を有している。

次に実施例について説明する。

実施例

ターゲットに純鉄、サブストレート(基板)にガラスを用い、デポジッション速度を、およそ $500 \sim 1000 \text{ \AA}/\text{min}$ として行つた。ガラスのサブストレートは銅製ホルダーにセットし、基板温度が 300°C 以下となるように該銅製ホルダーを水冷した。

スパッタリング中の窒素ガス分圧は、次の2方法で制御した。

1. アルゴンと窒素の2つのポンペを用い、それぞれ流量調節バルブで制御する方法。
2. アルゴンと窒素の圧力比を予めセット(例えば $99:1$)した混合気体ポンペを用い、1つの流量調節バルブで制御する方法。

ターゲット電圧 0.5 kV 、電流密度 $4 \text{ mA}/\text{cm}^2$ で実施した。第1図にスパッタリング中の窒素分圧 P_{N_2} と飽和磁化 σ_s との関係を示す。該磁性材料は厚さ $3 \mu\text{m}$ である。 $P_{N_2} 1 \times 10^{-4} \text{ Torr}$ 以下、特に $P_{N_2} 4.0 \times 10^{-4} \text{ Torr}$ 近辺純鉄の $218 \text{ e.m.u.}/\text{gr}$

より高い σ_s が得られている。

次に熱磁気分析の結果を第2図に示す。

— は本発明磁性材料、--- は純鉄の加熱曲線である。加熱前では本発明の磁性材料 σ_s は純鉄の $\sigma_s = 218 \text{ e.m.u.}/\text{gr}$ よりも大きい。

この加熱曲線から明らかなように、約 200°C で磁化の減少がみられる。これは Fe_{10}N_2 のキュリ-点に相当すると考えられる。さらに加熱を続け、 300°C を越えると純鉄の σ_s よりも低下していく傾向がみられる。さらに 480°C 附近で σ_s の明瞭な減少があるがこれは Fe_3N のキュリ-点で σ_s は著しく低下している。

以上より明らかなように、本発明の磁性材料は、純鉄の σ_s よりも優れた σ_s すなわち飽和磁化を有していることが分り、そのことは、磁性材料中に Fe_{10}N_2 が多量に存在していることを意味する。

さらにまた、上記加熱曲線により、 Fe_{10}N_2 は Fe_3N へと変化していく段階で飽和磁化は、純鉄の飽和磁化よりも低下していくことが分り、そ

して、スパッタリング操作中では基板の温度を 300°C 以下、より好ましくは 200°C 以下に保持すべきことが明瞭となる。

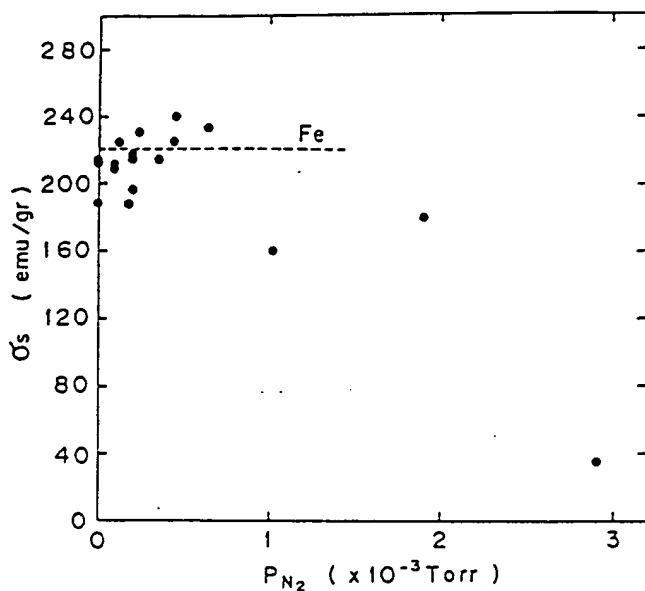
4. 図面の簡単な説明

第1図はスパッタリング時の窒素分圧 (P_{N_2}) と室温での飽和磁化との関係を示すグラフ、第2図は本発明で得られたスパッタリングフィルムの熱磁気分析による飽和磁化 σ_s と加熱温度との関係を示すグラフである。

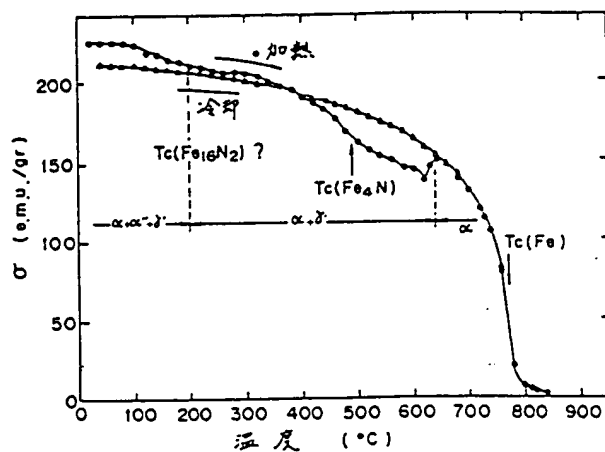
特許出願人 日本鉱業株式会社
代理人 弁理士(7569) 並川啓志

図面の浄書(内容に変更なし)

第 1 図



第 2 図



手続補正書 (方式)

昭和58年10月 / 日

特許庁長官 若 杉 和 夫 殿

1. 事件の表示

昭和57年特許願第35895号

2. 発明の名称

窒化鉄含有磁性材料およびその製造方法

3. 補正をする者

事件との関係 特許出願人

住 所 東京都港区虎ノ門二丁目10番1号

名 称 日本鉱業株式会社

代表者 笠 原 幸 雄

4. 代 理 人

〒105 電話 582-2111

住 所 東京都港区虎ノ門二丁目10番1号

日本鉱業株式会社内

氏 名 弁理士(7569) 並 川 啓 志

並川啓志
印

5. 補正命令の日付

昭和58年9月7日 (昭和58年9月27日発送)

6. 補正の対象 図 面

7. 補正の内容 図面の浄書 (内容に変更なし)